

Изобретение относится к технике и технологии оксидных полупроводников, в частности к сенсорам *n*-бутанола на основе гетероперехода ZnO-Al₂O₃.

Сенсор *n*-бутанола на основе гетероперехода ZnO-Al₂O₃ включает стеклянную подложку (1), на поверхность которой методом химического синтеза из раствора нанесена пленка из ZnO (2), а на ее поверхность вакуумным термическим испарением триизопрпилата Al [Al(C₃H₇O)₃] при температуре подложки (1) равной 450°C осаждается пленка Al₂O₃ (3) толщиной 17-20 нм, на поверхность которой осаждены меандровидные контакты из Au-Cr (4) и обработаны быстрым фотонным отжигом при T=650°C, t=30 с.

П. формулы: 1

Фиг.: 3

